

# 日程表(会場別1)

会場名	収容人数	3月15日(水)		3月16日(木)		3月17日(金)		3月18日(土)		
		午前	午後	午前	午後	午前	午後	午前	午後	
A201	150	11:00 ~ 12:00 授業式 (APEX/JIAP編集委員就職、論文賞、講演要約賞) 12:00 ~ 13:00 3.1 ナノ領域光科学・近接場光学 (旧3.1.2)	16:00 ~ 17:30 授業式 (業績賞、光・量子エレクトロニクス業績賞、化合物半導体エレクトロニクス業績賞、光工学功績賞、タイバシ・イ&インクルージョン賞) 17:30 ~ 18:00 3.2 情報フォトニクス・画像工学 (旧3.3)	10:00 ~ 11:15 3.1.1 ナノ領域光科学・近接場光学 (旧3.1.2) 11:15 ~ 12:00 3.2 情報フォトニクス・画像工学 (旧3.3)	13:30 ~ 18:00 T6 レーザーアプリケーションの新展開 18:00 ~ 19:00 3.8 テラヘルツ全般 (旧3.9)	13:00 ~ 17:15 3.1 光学基礎・光学新領域 (旧3.2) [材料・機器光学と統合] 17:15 ~ 18:00 3.1.1 ナノ領域光科学・近接場光学 (旧3.1.2)	13:00 ~ 17:45 3.1.3 光制御デバイス・光ファイバー (旧3.1.4)	09:30 ~ 11:30 3.1 光学基礎・光学新領域 (旧3.2) [材料・機器光学と統合] 11:30 ~ 12:00 3.1.3 光制御デバイス・光ファイバー (旧3.1.4)	13:00 ~ 16:00 3.1 光学基礎・光学新領域 (旧3.2) [材料・機器光学と統合] 16:00 ~ 17:00 3.1.3 光制御デバイス・光ファイバー (旧3.1.4)	
A202	108	09:00 ~ 11:00 3.2 情報フォトニクス・画像工学 (旧3.3)	13:00 ~ 16:45 15.6 IV族系化合物 (SiC)	10:00 ~ 11:00 3.8 テラヘルツ全般 (旧3.9)	13:00 ~ 17:00 3.8 テラヘルツ全般 (旧3.9)	09:30 ~ 11:30 3.1.3 光制御デバイス・光ファイバー (旧3.1.4)	13:00 ~ 17:45 3.8 テラヘルツ全般 (旧3.9)	09:00 ~ 11:15 CS.6 8.3 フラズマナノテクノロジー、9.2 ナノ粒子・ナノワイヤ・ナノシート、13.6 ナノ構造・量子現象・ナノ量子デバイスのコード化セッション	09:00 ~ 11:15 CS.6 8.3 フラズマナノテクノロジー、9.2 ナノ粒子・ナノワイヤ・ナノシート、13.6 ナノ構造・量子現象・ナノ量子デバイスのコード化セッション	
A205	246	09:00 ~ 12:10 チュートリアル(高梨弘毅 (日本原子力研究開発機構))	13:30 ~ 16:55 T10 水素化合物の研究最前線→物質開発動向	09:30 ~ 11:45 15.3 III-V族エレクトロニクス結晶・エピタキシーの基礎	13:30 ~ 17:55 T9 ミニLEDエレクトロニクス～誘電体ミーム共振器の物理と応用	09:00 ~ 11:30 8.2 フラズマ成膜・エッチング・表面処理	13:00 ~ 17:45 8.2 フラズマ成膜・エッチング・表面処理	10:00 ~ 14:30 8.5 フラズマ現象・新応用・融合分野	13:00 ~ 14:30 8.5 フラズマ現象・新応用・融合分野	
A301	246	09:30 ~ 11:30 15.6 IV族系化合物 (SiC)	13:00 ~ 16:45 15.6 IV族系化合物 (SiC)	09:30 ~ 12:00 13.7 化合物及びパワーデバイス・プロセス技術・評価	13:00 ~ 17:30 13.7 化合物及びパワーデバイス・プロセス技術・評価	09:00 ~ 11:30 13.7 化合物及びパワーデバイス・プロセス技術・評価	13:00 ~ 18:00 13.7 化合物及びパワーデバイス・プロセス技術・評価	09:00 ~ 12:30 13.7 化合物及びパワーデバイス・プロセス技術・評価	09:00 ~ 12:30 13.7 化合物及びパワーデバイス・プロセス技術・評価	
A302	200	09:00 ~ 12:10 チュートリアル(高梨弘毅 (日本原子力研究開発機構))	13:30 ~ 16:55 T10 水素化合物の研究最前線→物質開発動向	09:00 ~ 11:30 13.9 化合物太陽電池	13:30 ~ 18:25 T12 マクロ/ナノスケール微細加工の表面界面先端技術	09:00 ~ 10:30 6.2 カーボン系薄膜	13:30 ~ 16:15 CS.4 3.10 フォトニック構造・現象、3.12 半導体デバイス・プロセス	10:00 ~ 11:30 6.3 酸化エレクトロニクス	13:00 ~ 17:15 T14 脳生体自律分散システムにおける情報処理・創造の最前線	
A303	102	09:00 ~ 11:30 チュートリアル(大場 富仁(ラムサーチ会社))	13:30 ~ 18:20 T5 自在な量子制御に向けた光=物質強結合系の科学	09:00 ~ 11:15 3.4 レーザー装置・材料 (旧3.5)	10:00 ~ 16:45 3.2 情報フォトニクス・画像工学 (旧3.3)	09:30 ~ 11:30 3.1.2 半導体デバイス (旧3.1.3)	13:30 ~ 16:15 CS.4 3.10 フォトニック構造・現象、3.12 半導体デバイス・プロセス	10:00 ~ 11:30 6.3 酸化エレクトロニクス	13:00 ~ 16:00 3.1.1 ナノ領域光科学・近接場光学 (旧3.1.2)	
A304	150	09:00 ~ 11:30 チュートリアル(大場 富仁(ラムサーチ会社))	13:30 ~ 18:20 T5 自在な量子制御に向けた光=物質強結合系の科学	09:30 ~ 11:30 13.9 化合物太陽電池	13:00 ~ 16:30 13.9 化合物太陽電池	09:00 ~ 12:10 T4 加速器質量分析の現状と未来	14:00 ~ 17:10 T15 イオンビーム分析の最新動向	13:00 ~ 17:30 3.1.1 ナノ領域光科学・近接場光学 (旧3.1.2)	09:00 ~ 11:30 3.1.1 ナノ領域光科学・近接場光学 (旧3.1.2)	
A305	108	09:00 ~ 12:15 3.1.5 Optics and Photonics English Session	14:00 ~ 17:00 3.4 レーザー装置・材料 (旧3.5)	10:00 ~ 11:15 3.4 レーザー装置・材料 (旧3.5)	10:00 ~ 11:15 3.4 レーザー装置・材料 (旧3.5)	09:00 ~ 11:30 3.1.1 ナノ領域光科学・近接場光学 (旧3.1.2)	13:00 ~ 17:30 3.1.1 ナノ領域光科学・近接場光学 (旧3.1.2)	09:00 ~ 11:30 3.1.1 ナノ領域光科学・近接場光学 (旧3.1.2)	13:00 ~ 16:00 3.1.1 ナノ領域光科学・近接場光学 (旧3.1.2)	
A307	405	13:30 ~ 16:55 NT2 日本の才能発掘プロジェクト - 高等専門学校と応用物理学学会の絆 -	13:30 ~ 16:55 NT2 日本の才能発掘プロジェクト - 高等専門学校と応用物理学学会の絆 -	09:00 ~ 12:00 CS.8 12.6 ナノバイオテクノロジー、12.7 医用工学、バイオチップのコード化セッション	13:30 ~ 18:20 T7 ナノ光熱変換が拓く異分野融合型材料科学の新地平	09:30 ~ 11:45 T9 量子コンピュータ・エン지니어リングデバイス技術の最前線	13:30 ~ 17:00 T29 量子コンピュータ・エン지니어リングデバイス技術の最前線	13:30 ~ 16:45 T18 スピンLEDデバイス・マグネティックによる微細生体画像計測技術の進展	13:30 ~ 16:45 T18 スピンLEDデバイス・マグネティックによる微細生体画像計測技術の進展	
A401	246	09:00 ~ 11:45 12.5 有機/ハイブリッド太陽電池	13:00 ~ 18:00 12.5 有機/ハイブリッド太陽電池	09:00 ~ 11:45 12.5 有機/ハイブリッド太陽電池	13:00 ~ 18:00 12.5 有機/ハイブリッド太陽電池	09:00 ~ 10:15 12.5 有機/ハイブリッド太陽電池	13:00 ~ 17:15 23.1 合同セッション「インフォーマティクス応用」	09:00 ~ 11:30 23.1 合同セッション「インフォーマティクス応用」	13:00 ~ 16:30 23.1 合同セッション「インフォーマティクス応用」	
A402	200	13:30 ~ 17:55 NT1 クラウド・プラットフォーム・IoT むかひ物理：持続可能な未来社会に向けて	13:30 ~ 17:55 NT1 クラウド・プラットフォーム・IoT むかひ物理：持続可能な未来社会に向けて	09:15 ~ 10:45 8.1 フラズマ生成・診断 11:00 ~ 11:45 8.7 フラズマエレクトロニクス分科内招待講演	13:30 ~ 19:00 T16 フラズマ駆動型科学とは何か～プラズマプロセスの新展開に期待して～	09:30 ~ 12:05 NT3 就活生必見！日本が止まるど世界が止まる～わたしたちの半導体人材育成と産学連携	13:45 ~ 18:30 NT4 これからの半導体産業を牽引する人材育成と産学連携	13:00 ~ 17:50 NT5 多様な視点から進むダイバーシティ&インクルージョン	13:00 ~ 17:50 NT5 多様な視点から進むダイバーシティ&インクルージョン	
A403	102	13:00 ~ 17:15 13.2 探索的材料物性・量産物性	13:00 ~ 17:15 13.2 探索的材料物性・量産物性	09:00 ~ 11:45 13.5 デバイス/配線/集積化技術	13:00 ~ 18:45 13.5 デバイス/配線/集積化技術	09:00 ~ 11:45 13.5 デバイス/配線/集積化技術	13:00 ~ 17:45 13.5 デバイス/配線/集積化技術	13:00 ~ 16:00 T1 技術継承を要するための社会人教育・生涯学習の展開	13:00 ~ 16:00 T1 技術継承を要するための社会人教育・生涯学習の展開	
A404	150	13:00 ~ 18:30 6.1 強誘電体薄膜	13:00 ~ 18:30 6.1 強誘電体薄膜	09:00 ~ 12:30 T11 誘電体研究における機械学習	13:00 ~ 18:00 T12 物質の超秩序構造とその応用～結晶と非晶の境界のはざまの科学～	09:30 ~ 11:30 T3 放射線計測に利用可能な様々な材料	13:00 ~ 15:00 T3 放射線計測に利用可能な様々な材料	09:00 ~ 11:30 1.2 教育	13:00 ~ 16:00 1.2 教育	
A405	108	09:00 ~ 11:15 3.3 生体・医用光学 (旧3.4)	13:00 ~ 15:30 3.3 生体・医用光学 (旧3.4)	10:00 ~ 11:30 3.9 量子物理・技術 (旧3.10)	13:25 ~ 17:15 3.9 量子物理・技術 (旧3.10)	09:00 ~ 11:30 3.6 レーザー・プロセス (旧3.7)	13:00 ~ 16:45 3.6 レーザー・プロセス (旧3.7)	09:00 ~ 11:30 3.6 レーザー・プロセス (旧3.7)	13:00 ~ 16:00 3.6 レーザー・プロセス (旧3.7)	
A408	150	09:00 ~ 11:30 6.2 カーボン系薄膜	13:00 ~ 16:45 6.2 カーボン系薄膜	09:00 ~ 11:30 6.2 カーボン系薄膜	13:00 ~ 17:45 6.2 カーボン系薄膜	09:30 ~ 11:30 6.3 酸化エレクトロニクス	13:00 ~ 16:45 6.3 酸化エレクトロニクス	09:00 ~ 11:30 6.3 酸化エレクトロニクス	13:00 ~ 15:15 6.3 酸化エレクトロニクス	
A409	150	10:00 ~ 11:30 6.3 酸化エレクトロニクス	13:00 ~ 16:00 6.3 酸化エレクトロニクス	09:00 ~ 11:45 3.1.4 シリコンフォトニクス・集積フォトニクス (旧3.15)	14:00 ~ 18:30 6.1 強誘電体薄膜	09:30 ~ 11:30 8.4 フラズママイクロエクス	13:30 ~ 16:00 8.4 フラズママイクロエクス	13:00 ~ 16:00 8.4 フラズママイクロエクス	13:00 ~ 16:00 8.4 フラズママイクロエクス	
A410	299	13:30 ~ 17:35 T20 ナノテクノロジーを駆使したウイルス検出最前線 - 7代感染症ウイルス検出速に検出可能なクワンテセンサーによるパンデミックのない社会の実現 -	13:30 ~ 17:35 T20 ナノテクノロジーを駆使したウイルス検出最前線 - 7代感染症ウイルス検出速に検出可能なクワンテセンサーによるパンデミックのない社会の実現 -	09:00 ~ 11:30 FS.1 フォーカスセッション「AIエレクトロニクス」	13:30 ~ 17:30 T17 量子物性・量子情報の防壁	13:30 ~ 17:55 T8 メタマテリアルを加速する応用物理 - 五感に広がるAR/VR -	09:30 ~ 12:20 T8 メタマテリアルを加速する応用物理 - 五感に広がるAR/VR -	14:00 ~ 17:50 T8 メタマテリアルを加速する応用物理 - 五感に広がるAR/VR -	09:00 ~ 11:30 FS.1 フォーカスセッション「AIエレクトロニクス」	13:00 ~ 15:30 FS.1 フォーカスセッション「AIエレクトロニクス」
A501	150	10:30 ~ 12:00 3.1.0 フォトニック構造・現象 (旧3.1.1)	13:30 ~ 15:30 3.1.0 フォトニック構造・現象 (旧3.1.1)	13:30 ~ 17:45 3.1.0 フォトニック構造・現象 (旧3.1.1)	13:30 ~ 17:45 3.1.0 フォトニック構造・現象 (旧3.1.1)	09:00 ~ 10:30 3.5 超高速・高強度レーザー (旧3.6)	13:00 ~ 16:15 3.5 超高速・高強度レーザー (旧3.6)	09:00 ~ 10:45 3.5 超高速・高強度レーザー (旧3.6)	13:00 ~ 16:30 3.5 超高速・高強度レーザー (旧3.6)	
A502	150	09:00 ~ 11:15 3.1.4 シリコンフォトニクス・集積フォトニクス (旧3.15)	13:10 ~ 18:00 3.1.4 シリコンフォトニクス・集積フォトニクス (旧3.15)	13:00 ~ 17:00 3.7 光計測技術・機器 (旧3.8)	13:00 ~ 17:00 3.7 光計測技術・機器 (旧3.8)	09:30 ~ 11:45 3.7 光計測技術・機器 (旧3.8)	13:00 ~ 17:30 3.7 光計測技術・機器 (旧3.8)	09:30 ~ 11:45 3.7 光計測技術・機器 (旧3.8)	13:00 ~ 17:30 3.7 光計測技術・機器 (旧3.8)	



# 日程表(会場別3)

会場名	3月15日(水)		3月16日(木)		3月17日(金)		3月18日(土)		
	午前	午後	午前	午後	午前	午後	午前	午後	
PA (本館)	[09:30-11:30] 17 ナノカーボン	[13:30-15:30] 10 スピントロニクス・マクネティクス	[09:30-11:30] 3.1 光学基礎・光学新領域 (旧3.2「材料・機器光学」統合) 3.2 情報フォトニクス・画像工学 (旧3.3) 3.3 生体・医用光学 (旧3.4) 3.5 超高速・高強度レーザー (旧3.6) 3.6 レーザープロセッシング (旧3.7) 3.7 光計測技術・機器 (旧3.8) 3.12 半導体光デバイス (旧3.13)	[13:30-15:30] 1.4 エネルギー変換・貯蔵・資源・環境超音波 13.4 Si系プロセス・Si系薄膜・MEMS・装置技術 13.7 化合物及びパワーデバイス・プロセス技術・評価 15.6 IV族系化合物 (SiC) 15.7 結晶評価, 不純物・結晶欠陥 FS.1 フォーカストセッション「AIエレクトロニクス」 [16:00-18:00] 6.3 酸化物エレクトロニクス 6.4 薄膜新材料 6.6 フロー・プロセス 22.1 合同セッションM「フロンティアエンジニアリング」	[13:30-15:30] 1.2 教育 1.3 新技術・複合新領域 1.5 計測技術・計測標準 3.13 光制御デバイス・光ファイバー (旧3.14) 3.14 シリコンフォトニクス・集積フォトニクス (旧3.15) 6.1 強誘電体薄膜 6.2 カーボン系薄膜 6.5 表面物理・真空	[09:30-11:30] 7 ビーム応用 9.2 ナノ粒子・ナノワイヤ・ナノシート 12.3 機能材料・萌芽的デバイス 12.4 有機EL・トランジスタ 16.3 シリコン系太陽電池	[16:00-18:00] 2 放射線		
	[09:30-11:30] 17 ナノカーボン	[13:30-15:30] 10 スピントロニクス・マクネティクス	[09:30-11:30] 3.1 光学基礎・光学新領域 (旧3.2「材料・機器光学」統合) 3.2 情報フォトニクス・画像工学 (旧3.3) 3.3 生体・医用光学 (旧3.4) 3.5 超高速・高強度レーザー (旧3.6) 3.6 レーザープロセッシング (旧3.7) 3.7 光計測技術・機器 (旧3.8) 3.12 半導体光デバイス (旧3.13)	[13:30-15:30] 1.4 エネルギー変換・貯蔵・資源・環境超音波 13.4 Si系プロセス・Si系薄膜・MEMS・装置技術 13.7 化合物及びパワーデバイス・プロセス技術・評価 15.6 IV族系化合物 (SiC) 15.7 結晶評価, 不純物・結晶欠陥 FS.1 フォーカストセッション「AIエレクトロニクス」 [16:00-18:00] 6.3 酸化物エレクトロニクス 6.4 薄膜新材料 6.6 フロー・プロセス 22.1 合同セッションM「フロンティアエンジニアリング」	[13:30-15:30] 1.2 教育 1.3 新技術・複合新領域 1.5 計測技術・計測標準 3.13 光制御デバイス・光ファイバー (旧3.14) 3.14 シリコンフォトニクス・集積フォトニクス (旧3.15) 6.1 強誘電体薄膜 6.2 カーボン系薄膜 6.5 表面物理・真空	[09:30-11:30] 7 ビーム応用 9.2 ナノ粒子・ナノワイヤ・ナノシート 12.3 機能材料・萌芽的デバイス 12.4 有機EL・トランジスタ 16.3 シリコン系太陽電池	[16:00-18:00] 2 放射線		
PB (7F7Jコロシアム)	[09:30-11:30] 3.4 レーザー装置・材料 (旧3.5)	[13:30] 3.8 テラヘルツ全般 (旧3.9) 3.9 光子物理・技術 (旧3.10) 8 フラスカエレクトロニクス	[09:30-11:30] 9.3 ナノエレクトロニクス 9.5 新機能材料・新物性 11 超伝導 13.1 Si系基礎物性・表面界面・シミュレーション 13.2 探査的物性・基礎物性 13.8 光物性・発光デバイス	[16:00-18:00] 1.1 応用物理一般・学際領域 3.10 フォトニック構造・現象 (旧3.11) 3.11 ナノ領域光学・近接場光学 (旧3.12)	[13:30-15:30] 9.1 誘電材料・誘電体 9.4 熱電変換 13.9 化合物太陽電池 15.1 バルク結晶成長 16.1 基礎物性・評価・プロセス・デバイス 23.1 合同セッション「インフオマティクス応用」	[09:30-11:30] 21.1 合同セッションK「ワイドギャップ化合物半導体材料・デバイス」 23.1 合同セッション「インフオマティクス応用」	[13:30-15:30] 9.1 誘電材料・誘電体 9.4 熱電変換 13.9 化合物太陽電池 15.1 バルク結晶成長 16.1 基礎物性・評価・プロセス・デバイス 23.1 合同セッション「インフオマティクス応用」	[09:30-11:30] 12.5 有機・ハイブリッド太陽電池	
	[09:30-11:30] 3.4 レーザー装置・材料 (旧3.5)	[13:30] 3.8 テラヘルツ全般 (旧3.9) 3.9 光子物理・技術 (旧3.10) 8 フラスカエレクトロニクス	[09:30-11:30] 9.3 ナノエレクトロニクス 9.5 新機能材料・新物性 11 超伝導 13.1 Si系基礎物性・表面界面・シミュレーション 13.2 探査的物性・基礎物性 13.8 光物性・発光デバイス	[16:00-18:00] 1.1 応用物理一般・学際領域 3.10 フォトニック構造・現象 (旧3.11) 3.11 ナノ領域光学・近接場光学 (旧3.12)	[13:30-15:30] 9.1 誘電材料・誘電体 9.4 熱電変換 13.9 化合物太陽電池 15.1 バルク結晶成長 16.1 基礎物性・評価・プロセス・デバイス 23.1 合同セッション「インフオマティクス応用」	[09:30-11:30] 21.1 合同セッションK「ワイドギャップ化合物半導体材料・デバイス」 23.1 合同セッション「インフオマティクス応用」	[13:30-15:30] 9.1 誘電材料・誘電体 9.4 熱電変換 13.9 化合物太陽電池 15.1 バルク結晶成長 16.1 基礎物性・評価・プロセス・デバイス 23.1 合同セッション「インフオマティクス応用」	[09:30-11:30] 12.5 有機・ハイブリッド太陽電池	